

文章内容

标题:	SiC—MESFET器件的夹断电压
作者:	王守国 ^{1,2} , 张义门 ¹ , 张玉明 ¹ , 张志勇 ² , 阎军锋 ²
发表年限:	2003
发表期号:	1
单位:	(1. 西安电子科技大学微电子研究所, 陕西西安 710071; 2. 西北大学电子科学系, 陕西西安 710069)
关键词:	碳化硅; 夹断电压; 界面态
摘要:	考虑空间电荷区杂质的非完全离化、SiC表面的界面态和反向漏电流等因素的影响, 给出了较为精确的计算SiC—MESFET器件夹断电压的方法, 计算的结果和实验值符合较好  SiC—MESFET器件的夹断电压.pdf

打印

关闭